

# **Robuste dreidimensionale Hall-Sensoren für mehrachsige Positionsmesssysteme**

**Dissertation  
zur Erlangung des Grades  
des Doktors der Ingenieurwissenschaften  
der Naturwissenschaftlichen-Technischen Fakultät II  
- Physik und Mechatronik -  
der Universität des Saarlandes**

**von  
Dipl.-Ing. Markus Stahl-Offergeld**

**Saarbrücken  
2010**

<b>Tag des Kolloquiums:</b>	<b>10.06.2011</b>
<b>Dekan:</b>	<b>Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Helmut Seidel</b>
<b>Mitglieder des Prüfungsausschusses:</b>	<b>Univ.-Prof. Dr.-Ing. Matthias Nienhaus</b> <b>Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schütze</b> <b>Univ.-Prof. Dr.-Ing. Chihao Xu</b> <b>Dr.-Ing. Hans-Peter Hohe</b>
<b>Akademische Mitarbeiterin/ Akademischer Mitarbeiter:</b>	<b>Dr.-Ing. Felix Felgner</b>

Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik  
Recent Developments in MEMS

Band 20

**Markus Stahl-Offergeld**

**Robuste dreidimensionale Hall-Sensoren  
für mehrachsige Positionsmeßsysteme**

Shaker Verlag  
Aachen 2011

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 2011

Copyright Shaker Verlag 2011

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8440-0303-1

ISSN 1862-5711

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: [www.shaker.de](http://www.shaker.de) • E-Mail: [info@shaker.de](mailto:info@shaker.de)

# Kurzfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung dreidimensionaler Hall-Sensoren in CMOS für mehrachsige Positionsmesssysteme.

Dies geschieht zum einen auf Hall-Elementebene, wo durch Modifikationen der Elementgeometrien und durch Verwendung zusätzlicher, normalerweise nicht benötigter Masken, die Eigenschaften der vertikalen Hall-Elemente verbessert werden. Des Weiteren wird die Verschaltung der vertikalen und lateralen Hall-Elemente hin zum 3D-Hall-Sensor untersucht und optimiert. Zum anderen werden mit neuen Methoden auf Systemebene die Eigenschaften des Sensorsystems unabhängig von den Hall-Elementen verbessert. Die Empfindlichkeit der Sensoren kann mit integrierten Spulen unabhängig von den Prozesstoleranzen sogar im laufenden Betrieb gemessen werden. Beim Offset lässt sich der Großteil mithilfe der Offsetzentrierung bereits im Hall-Element kompensieren. Anschließend kann der verbleibende Restoffset mithilfe auf dem Chip gemessener Offsettemperaturkoeffizienten nachgebildet werden.

Werden mehrere dieser 3D-Hall-Sensoren auf einem Chip platziert, so kann der Gradient der magnetischen Flussdichte in der Chipebene gemessen werden. Anschließend lässt sich sogar der Gradient senkrecht zur Chipebene mithilfe der Maxwellsschen Gleichungen berechnen. Mit diesen zusätzlichen linear unabhängigen Messgrößen lassen sich bisher nicht realisierbare robuste und mehrachsige Positions-messsysteme aufbauen.



# Abstract

This work deals with the development of CMOS integrated three-dimensional Hall sensors for multiaxial position measurement systems.

This is done, on the one hand on a Hall element level, where the properties of the Hall element are increased by modifications of the geometry of the element and by the use of normally unused layers. Furthermore, the wiring of the vertical and lateral Hall elements for use as a 3D Hall sensor is analysed and optimised. On the other hand, the properties of the sensor system are improved by new methods on a system level, independent of the Hall sensor. The sensitivity of the sensors can be measured independent of process tolerances, even during normal operation. The greater part of the offset can already be compensated by the use of the offset centering technique inside the Hall element. Subsequently, the residual offset can be replicated by the use of on-chip-measured offset temperature coefficients.

If several of these 3D Hall sensors are placed on one chip, the gradient of the magnetic flux density with respect to the in-plain axis of the chip surface can be measured. The gradient with respect to the perpendicular axis can be calculated by means of the Maxwell equations. With these additional, independent measured values it is possible to design robust and multiaxial position measurement systems, which could not be implemented so far.



# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b> . . . . .	1
1.1 Motivation . . . . .	1
1.2 Aufgabenstellung . . . . .	3
<b>2 Grundlagen</b> . . . . .	4
2.1 Der Hall-Effekt . . . . .	4
2.2 Empfindlichkeit . . . . .	7
2.3 Hall-Elemente in CMOS-Technologien . . . . .	8
2.3.1 Laterale Hall-Elemente . . . . .	9
2.3.2 Vertikale Hall-Elemente . . . . .	10
2.3.3 Messkette integrierter Hall-Elemente . . . . .	13
2.4 Störeffekte bei integrierten Hall-Elementen . . . . .	14
2.4.1 Reduktion der theoretisch erreichbaren Empfindlichkeit . . . . .	15
2.4.1.1 Kurzschlusseffekte . . . . .	15
2.4.1.2 Temperatureinfluss . . . . .	17
2.4.1.3 Piezo-Hall-Effekt . . . . .	19
2.4.2 Offset . . . . .	20
2.4.3 Rauschen . . . . .	22
2.4.4 Dynamikbereich . . . . .	24
2.4.5 Messunsicherheit . . . . .	26
2.5 Reduktion von Störeffekten . . . . .	27
2.5.1 Integrierter Erregerleiter . . . . .	27
2.5.2 Spinning Current . . . . .	30
2.5.3 Orthogonale Paarbildung lateraler Hall-Elemente . . . . .	32
2.5.4 Zwangssymmetrierung vertikaler Hall-Elemente . . . . .	33
2.5.5 Chopper-Prinzip . . . . .	34
2.6 Dreidimensionale Hall-Sensoren . . . . .	36
2.6.1 3D-Hall-Sensor aus Einzelsensoren . . . . .	36
2.6.2 In einem Punkt messendes 3D-Hall-Element . . . . .	38
2.6.3 3D-Hall-Sensor auf Basis eines Flusskonzentrators . . . . .	38
2.7 Robuste Messsysteme am Beispiel eines Winkelsensors . . . . .	39
2.7.1 Direkte Auswertung einer linear unabhängigen Messgröße . . . . .	40
2.7.2 Quotientenauswertung zweier linear unabhängiger Messgrößen . . . . .	41
2.7.3 Gradientenauswertung mit vier linear unabhängigen Messgrößen . . . . .	43
2.8 Mehrdimensionale Messsysteme . . . . .	45
<b>3 Anforderungen an robuste dreidimensionale Hall-Sensoren für mehrachsige Positionsmesssysteme</b> . . . . .	48
3.1 Eigenschaften der robusten 3D-Hall-Sensoren . . . . .	49
3.1.1 Benötigte Empfindlichkeit . . . . .	50

3.1.2	Maximal zulässiger Offset . . . . .	51
3.2	Integrierte Überwachung . . . . .	52
3.3	Mehrachsige Positionsmesssysteme . . . . .	52
3.4	Geometrie des 3D-Sensors . . . . .	53
<b>4</b>	<b>Messaufbauten und Testchips . . . . .</b>	<b>54</b>
4.1	Charakterisierung in der Klimakammer . . . . .	54
4.2	Linearitäts- und Winkelmessungen auf dem Hexapodmessplatz . . . . .	56
4.3	Auswertung der Messergebnisse . . . . .	58
4.4	Basis-Testchip . . . . .	60
<b>5</b>	<b>Neue physikalische Konzepte vertikaler Hall-Sensoren . . . . .</b>	<b>62</b>
5.1	Der Hochvolt-CMOS-Prozess und seine Potenziale bei Hall-Elementen . . . . .	62
5.2	Reproduzierbarkeit der Elementgeometrie . . . . .	64
5.2.1	Größe der Hall-Elemente . . . . .	65
5.2.2	Gate-Poly . . . . .	70
5.2.3	Ausrichtung der Sensoren (45°) . . . . .	74
5.3	Geometrische Effizienz . . . . .	78
5.3.1	PTUB-Barrieren . . . . .	78
5.3.2	Kontaktgeometrie . . . . .	82
5.4	Gleichlauf der Empfindlichkeit zwischen lateralen und vertikalen Hall-Sensoren . . . . .	85
5.5	Offsetarme Verdrahtung der Sensoren . . . . .	88
5.5.1	Raumladungszonen-Simulationsmodell eines vertikalen Hall-Elements . . . . .	89
5.5.2	Simulationen zum verdrahtungsabhängigen Offset . . . . .	89
5.5.3	Messergebnisse des verdrahtungsabhängigen Offsets . . . . .	93
5.6	Aufbau des 3D-Sensors und die Auswirkungen auf die Linearität . . . . .	94
5.6.1	Simulationen zur Elementanordnung . . . . .	94
5.6.2	Messergebnisse zur Elementanordnung . . . . .	97
<b>6</b>	<b>Neue Möglichkeiten zur messsystembedingten Signalaufbereitung und Offsetreduzierung . . . . .</b>	<b>99</b>
6.1	Erregerleiter der Pixel-Zelle . . . . .	99
6.1.1	Interferenzspule . . . . .	101
6.1.2	Realisierung und Messergebnisse . . . . .	106
6.1.3	Prozesstolerante Ergiebigkeitsbestimmung der Interferenzspule . . . . .	107
6.1.4	Realisierung und Messergebnisse der prozesstoleranten Interferenzspule . . . . .	111
6.2	Offsetzentrierung . . . . .	113
6.2.1	Realisierungsmöglichkeiten der Offsetzentrierung . . . . .	115
6.2.2	Messung zur Offsetzentrierung . . . . .	119
6.3	Offsetnachführung mittels Offsettemperaturkoeffizienten . . . . .	122

6.3.1	Berechnung des Offsettemperaturkoeffizienten . . . . .	123
6.3.2	Überwachung des externen Magnetfeldes . . . . .	124
6.3.3	Testchip zur Offsetnachführung . . . . .	125
6.3.4	Messergebnisse Offset nach Offsetnachführung . . . . .	125
6.4	Gradientenberechnungen mit Matrix-Pixel-Zellen . . . . .	127
6.4.1	Gradienten erster Ordnung senkrecht zur Chipoberfläche . . . . .	130
6.4.2	Gradienten zweiter Ordnung senkrecht zur Chipoberfläche . . . . .	132
6.4.3	Messergebnisse der z-Gradienten . . . . .	134
6.4.4	Analoge Gradientenmessung . . . . .	138
<b>7</b>	<b>Robuster Gradienten-Hall-Sensor-IC</b> . . . . .	140
7.1	Der ideale robuste Gradienten-Hall-Sensor-IC . . . . .	140
7.2	Robuster Gradienten-Hall-Demonstrator-IC . . . . .	144
7.2.1	Drehwinkelmessungen . . . . .	146
7.2.1.1	Auf Absolutwerten basierende On-Axis Winkelmessung . . . . .	146
7.2.1.2	Auf Gradienten basierende On-Axis Winkelmessung . . . . .	148
7.2.1.3	Auf Absolutwerten basierende Off-Axis Winkelmessung . . . . .	149
7.2.1.4	Auf Gradienten basierende Off-Axis Winkelmessung . . . . .	151
7.2.2	Messungen zu mehrachsigen Positionsmesssystemen . . . . .	153
<b>8</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick</b> . . . . .	155
<b>9</b>	<b>Literatur und Quellenverzeichnis</b> . . . . .	158
<b>10</b>	<b>Anhang</b> . . . . .	164
A	Konforme Abbildung . . . . .	164
B	Mathcad Skripte . . . . .	165
B.1	Sensoren . . . . .	165
B.2	Linearität . . . . .	166
B.3	Winkelfehler . . . . .	170
B.4	Erregerleitung Triangulation . . . . .	172
C	Herleitungen Offsetzentrierung . . . . .	175
C.1	Offsenterzeugung im Sensor . . . . .	175
C.2	Offsenterzeugung im Verstärker . . . . .	176
D	Testchips . . . . .	177
D.1	Typ-I . . . . .	177
D.2	Typ-K . . . . .	178
D.3	Typ-M . . . . .	180
D.4	Typ-O . . . . .	181
D.5	Typ-P . . . . .	182
D.6	Typ-Q . . . . .	185
D.7	Typ-R . . . . .	185
D.8	Typ-S . . . . .	186
D.9	H35T04 . . . . .	187
E	Formelzeichen und Symbole . . . . .	188

F	Verwendete Konstanten . . . . .	190
G	Verwendete Abkürzungen . . . . .	191
H	Abbildungsverzeichnis . . . . .	193
I	Tabellenverzeichnis . . . . .	200